

## MOSFET: resultados

1. - Gate=1 Dreno=2 Source=3  $V_{GS}=3V$   $I_D=1mA$   $V_{DS}=5V$

2. -  $R_1=444k\Omega$   $R_2=363k\Omega$

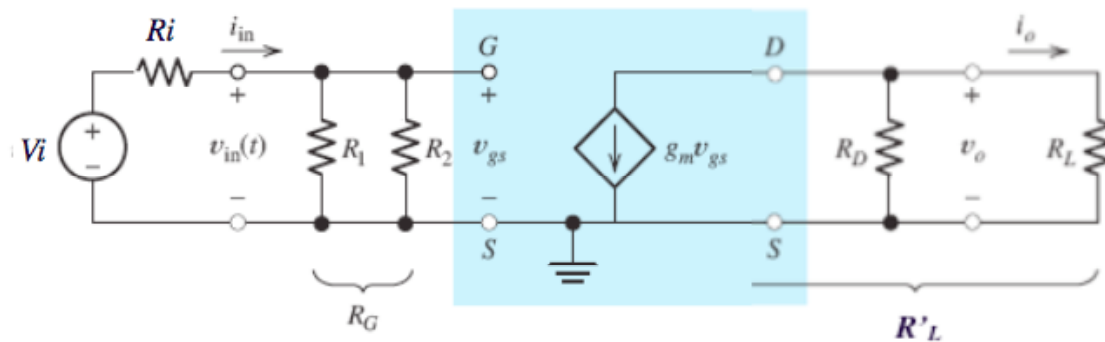
3. - a)  $V_{GS}=3V$   $I_D=10mA$   $V_{DS}=9V$

b) Ver 4.b) com  $R_i=0\Omega$  e  $R_L=\infty\Omega$

c)  $V_o/V_i = -10$

4. - a)  $I_D=2mA$   $R_2=10k\Omega$   $V_{DS}=4V > V_{GS}-V_{to}$  (saturação)

b)



c)  $V_o/V_i = -2,67$

5. -  $V_{GS}=2,5V$   $I_D=7,94mA$   $V_{DS}=2,5V$  para ambos os transistores.

6. -  $I_D = 10mA$   $R_D = 250\Omega$